



2Т8266А,Б

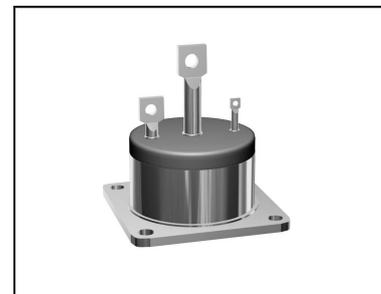
МОЩНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ N-P-N ТРАНЗИСТОР

Применение:

Электропривод

Описание:

Мощные высоковольтные кремниевые n-p-n транзисторы, изготовленные по меза-планарной технологии, в металлокерамическом корпусе с изолированным коллектором



• Предельно допустимые режимы эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма | | Примечание |
|--|-----------------------|---------|---------|------------|
| | | 2Т8266А | 2Т8266Б | |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В | $U_{КБ\ max}$ | 300 | 150 | 1 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В | $U_{КЭ\ max}$ | 200 | 100 | 1 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | $U_{ЭБ0\ max}$ | 5 | 5 | 1 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А | $I_{К\ max}$ | 300 | 300 | 1 |
| Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А | $I_{К,и\ max}$ | 400 | 400 | 1 |
| Максимально допустимый ток базы, А | $I_{Б\ max}$ | 50 | 50 | 1 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | $P_{К\ max}$ | 300 | 300 | 1, 2 |
| Максимально допустимая температура перехода, °С | $T_{п\ max}$ | 150 | 150 | |
| Максимально допустимая температура корпуса, °С | $T_{К\ макс}$ | 125 | 125 | |

Примечания:

1 В диапазоне температур корпуса от минус 60°С до плюс 125°С.

2 При температуре корпуса свыше 25°С до плюс 125°С рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле:

$$P_{К} = \frac{T_{п\ макс} - T_{корп}}{R_{т\ п-к}}, \text{ Вт}$$

где $R_{т\ п-к}$ – установившееся тепловое сопротивление переход-корпус, равное 0,42 °С/Вт.

• Основные электрические параметры

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквен- ное обозна- чение | Норма | | | | Темпе- ратура (среды) корпуса, °C |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | 2Т8266А | | 2Т8266Б | | |
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Обратный ток коллектора ($U_{КБ}=300\text{ В}$), мА | $I_{КБ0}$ | - | 3,0 | | | 25 |
| | | - | 5,0 | | | -60 |
| | | - | 6,0 | | | 125 |
| (U _{КБ} =150 В), мА | | | | - | 3,0 | 25 |
| | | | | - | 5,0 | -60 |
| | | | | - | 6,0 | 125 |
| Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}=5\text{ В}$), мА | $I_{ЭБ0}$ | - | 25 | - | 25 | 25 |
| Статический коэффициент передачи тока ($U_{КЭ}=5\text{ В}$, $I_{К}=150\text{ А}$) | $h_{21Э}$ | 10 | - | 10 | - | 25 |
| | | 8 | - | 8 | - | -60 |
| | | 8 | - | 8 | - | 125 |
| ($U_{КЭ}=5\text{ В}$, $I_{К}=300\text{ А}$) | | 2 | | 2 | | 25 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б}=30\text{ А}$), В | $U_{КЭ\text{нас}}$ | - | 2,0 | - | 2,0 | 25 |
| | | - | 2,5 | - | 2,5 | -60 |
| | | - | 2,5 | - | 2,5 | 125 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б}=30\text{ А}$), В | $U_{БЭ\text{нас}}$ | | 3,0 | | 3,0 | 25 |
| Граничное напряжение ($I_{К}=0,1\text{ А}$, $L=25\text{ мГн}$), В | $U_{КЭ0гр}$ | 200 | - | 100 | - | 25 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт | $R_{Тп-к}$ | | 0,42 | | 0,42 | |

• Временные характеристики

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквен- ное обозна- чение | Норма | | | | Темпе- ратура (среды) корпуса, °C |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | 2Т8266А | | 2Т8266Б | | |
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Время рассасывания ($U_{КЭ}=50\text{ В}$, $I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б1} = - I_{Б2} = 30\text{ А}$), мкс | $t_{рас}$ | | 3,0 | | 3,0 | 25 |
| Время спада ($U_{КЭ}=50\text{ В}$, $I_{К}=150\text{ А}$, $I_{Б1} = - I_{Б2} = 30\text{ А}$), мкс | $t_{сп}$ | | 1,0 | | 1,0 | 25 |

